









	<h2 style="color: red;">FQD3P20TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD3P20TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD3P20TF.pdf 2.FQD3P20TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1950 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD3P20TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1950 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 2.4A (Tc) 2.5W (Ta), 37W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 37W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 Ohm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD3P20TF ist neu im Original, Suche FQD3P20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3P20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3P20TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD3P20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3P50TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.1A DPAK</p>	 <p>FQD3P20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>
 <p>FQD3P20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor FQD3N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQD3N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3P50 FAIRCHI FQD3P50 FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD30N06TM	↔ FQD30P06	⇒ FQD3N25T	D FQD3N30TF	⇒ FQD3N30TF
⊕ FQD3N30TM	⊗ FQD3N30TM	D FQD3N40TM	⇒ FQD3N40TM	⇒ FQD3N50C
⊗ FQD3N50C/CS	⊕ FQD3N50CTF	⊗ FQD3N50CTF	↔ FQD3N50CTM	⇒ FQD3N50CTM
D FQD3N60C	⊗ FQD3N60CS	⊕ FQD3N60CTF	⊗ FQD3N60CTM	⇒ FQD3N60CTM_WS
⇒ FQD3N60TF	↔ FQD3N60TF	⊗ FQD3N60TM	⊕ FQD3N60TM	⇒ FQD3P20TF
↔ FQD3P50TF	⇒ FQD3P50TF	D FQD3P50TM	⊗ FQD3P50TM	⊕ FQD4N20L
⊗ FQD4N20LTF	D FQD4N20LTF	⇒ FQD4N20TF	↔ FQD4N20TF	⇒ FQD4N20TM
⊕ FQD4N20TM	⊗ FQD4N25TM	↔ FQD4N25TM	⇒ FQD4N50S	⇒ FQD4N50T
⊗ FQD4N50TF	⊕ FQD4N50TF	⊗ FQD4N50TM	D FQD4N50TM	⇒ FQD4N60C
↔ FQD4N60CTM	⊗ FQD4N65C	⊕ FQD4P25TM	⊗ FQD4P25TM	⇒ FQD5N15TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited